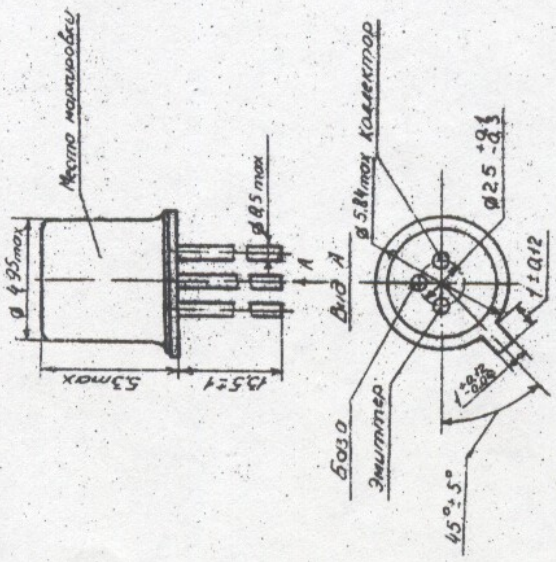




ТРАНСИСТОР ЭЛЕКТРОН  
ЭЛЕКТРОН

Кремниевый инжекционный транзистор с частотными характеристиками и-п-п транзистора  
ЭЛЕКТРОН в металлическом корпусе с изолятором, предназначенный для работы в аппаратура  
специального назначения.

Климатическое исполнение ЭИ



Масса не более 0,4 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦМН  $T_{c20}$  (25±10) °C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Ст. эскый коэффициент передачи тока в режиме с открытым эмиттером ( $U_{кз} = 5$ В, $I_э = 200$ мА, $T_п \leq 30$ мкс, $Q \geq 50$ )	$h_{213}$	40	200
	$h_{213} / I_{кз0}$	3	5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $U_{кз} = 10$ В, $I_э = 30$ мА, $f = 10^6$ Гц)	$I_{кз0}$		5
	$I_{эБ0}$		5
Обратный ток коллектора, мА, ( $U_{кз} = 60$ В)	$I_{кз0}$		0,5
	$I_{эБ0}$		1,2
Обратный ток эмиттера, мА, ( $U_{эБ} = 4$ В)	$I_{кз0}$		10
	$I_{эБ0}$		80
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ( $I_э = 50$ мА, $I_к = 500$ мА)	$U_{кэнас}$		
	$U_{эБнас}$		
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, ( $I_э = 50$ мА, $I_к = 500$ мА)	$U_{кэнас}$		
	$U_{эБнас}$		
Емкость коллекторного перехода, пФ, ( $U_{кэ} = 10$ В, $I_э = 0$ , $f = 10^7$ Гц)	$C_к$		
	$C_э$		
Емкость эмиттерного перехода, пФ, ( $U_{эБ} = 0$ , $f = 10^7$ Гц)	$C_к$		
	$C_э$		

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Время восстановления, нс, ( $I_к = 500$ мА, $I_э = I_{э2} = 50$ мА, $U_{кэ} \leq 30$ В, $Q \geq 50$ )	$t_{вос}$		60

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНСИСТОРОВ:

Золото  $7,8815$  г  
в том числе:  
золото  $2,000744$  г/мм на 3 микроллитра жидкой  $13,5$  мм

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕПКИ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОБЪЕМ ТРАНСИСТОРОВ:  
Никель  $117-2 - 0,125$  г

СВЯЗЬ С ИСТОЧНИКОМ

Транзистор типа ЭЛЕКТРОН соответствует техническим условиям А.О.338.266 Т.

Принят во исполнение от **115 8** от **20 ФЕВ 1991**

Место для штампа: **216** Место для штампа: **ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Место для штампа: **216** Место для штампа: **ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Место для штампа: **216** Место для штампа: **ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Место для штампа: **216** Место для штампа: **ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

86

301 5669